

## Transistor IRF640N MOSFET N 200V 18A

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVIRF640N



Transistor IRF640N MOSFET N 200V 18A

Polarité transistor Canal N  
Courant de drain Id 18A  
Tension Vds max.. 200V  
Résistance Rds(on) 0.15ohm  
Tension, mesure Rds 10V  
Tension de seuil Vgs 4V  
Dissipation de puissance Pd 150W  
Type de boîtier de transistor TO-220AB  
Température max.. 175°Ca

Packaging :		
Dimensions produit :	1mm X 1mm X Ø 1mm	Poids : 1g
<i>Données non contractuelles</i>		